

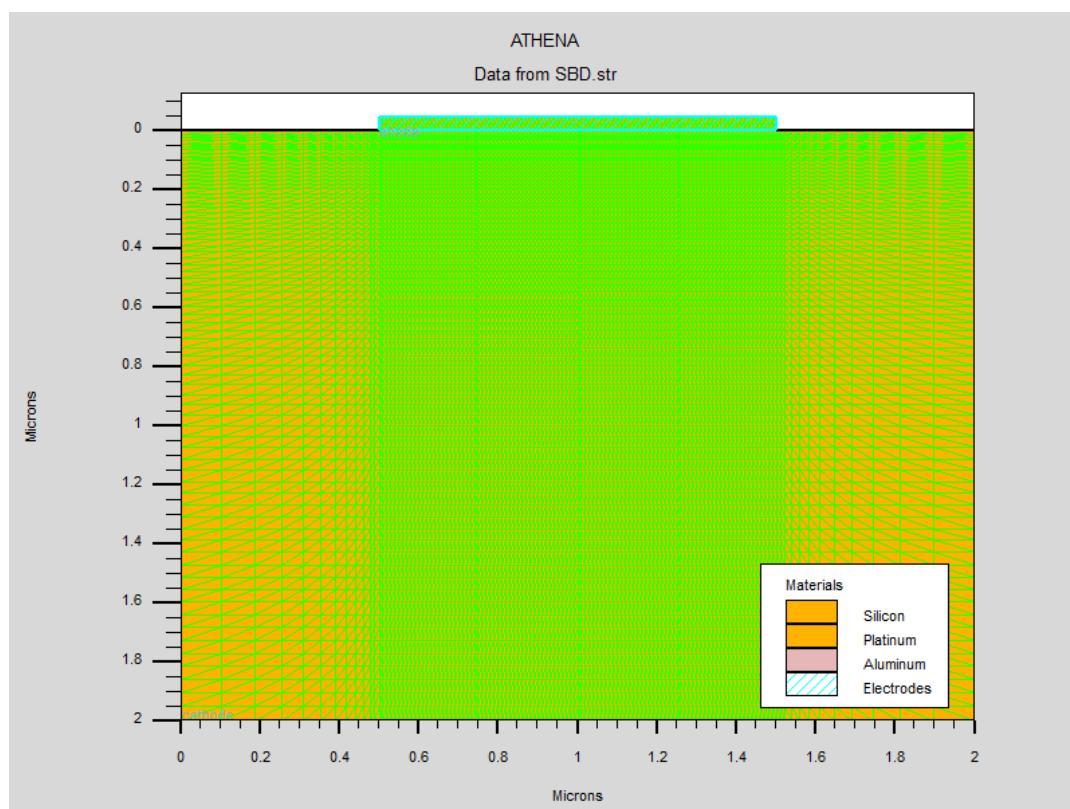
实验二

作业一：请描述所仿真的器件结构(如掺杂浓度，厚度)

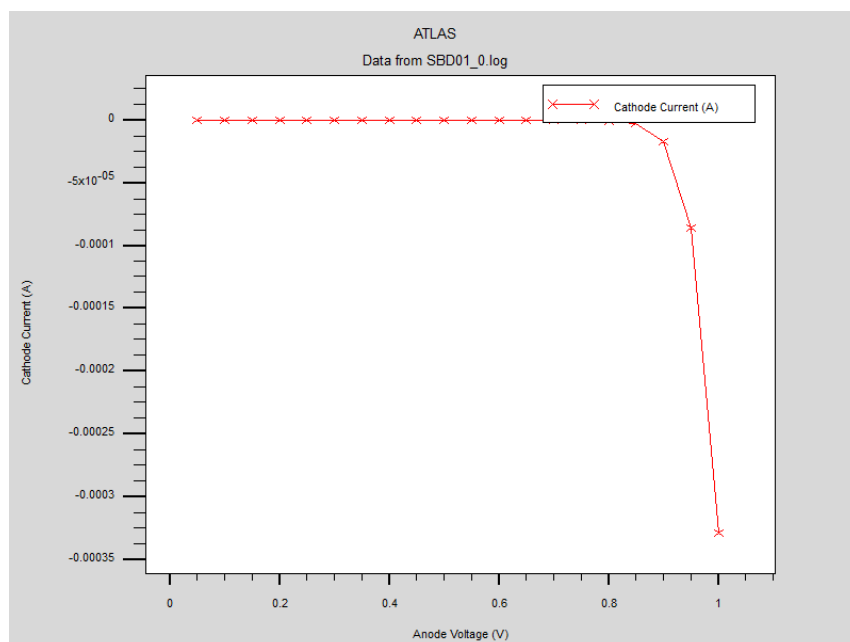
器件的最底层是 2 μm 厚的 Si，掺杂浓度为 $1\text{e}18\text{cm}^{-3}$ ，然后其上是一层厚度为 0.05 μm 的 Pt，宽度为 1 μm

作业二：请给出所设计器件的：纵向结构图，I-V 特性图

纵向结构图如下所示：



I-V 特性图：



作业三：请给出所设计器件的横向结构图：

